查询SG105供应商
捷多邦，专业PCB打样工厂，24小时加急出货

フォトインタラプタ　PHOTOINTERRUPTERS

KODENSHI CORP.

# SG-105

SG-105 は、赤外発光ダイオードと、高感度フォトトランジスタを超小型樹脂にモールドした反射型フォトセンサで、取り付けスペースの削減が出来ます。

The SG-105 reflective sensor combines a GaAs IRED with a high-sensitivity phototransistor in a super-mini package, reducing installation space.

## ■特長　FEATURES

- ●基板直付けタイプ
- ●最適検出距離：0.8mm
- ●可視光カットタイプ
- ●薄型

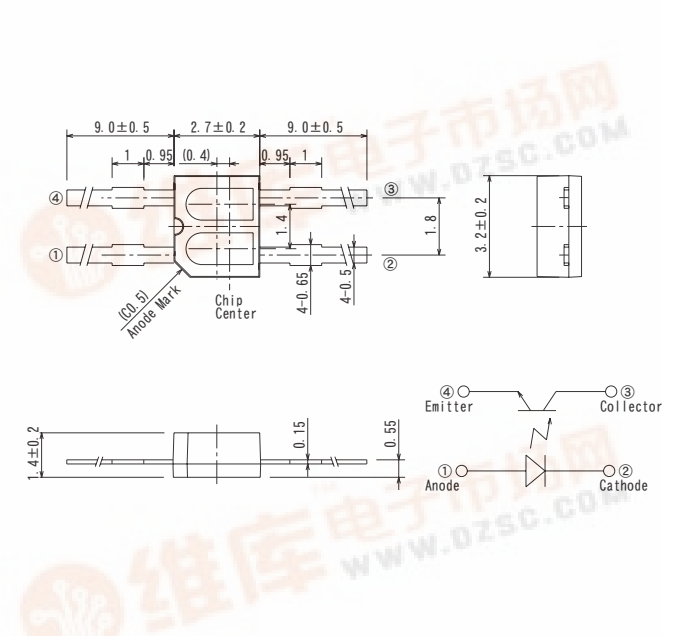
- ●PWB direct mount type
- ●The most suitable detection distance : 0.8mm
- ●Visible light cut off type
- ●Low profile

## ■用途　APPLICATIONS

- ●カセットメカ
- ●カメラ
- ●小型プリンター
- ●VTR

- ●Cassette mecha
- ●Cameras
- ●Mini printers
- ●VTR

## ■外形寸法　DIMENSIONS (Unit : mm)




## ■最大定格 MAXIMUM RATINGS

(Ta=25℃)

| Item | | | Symbol | Rating | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| 入力 Input | 許容損失 | Power dissipation | $P_D$ | 75 | mW |
| | 順電流 | Forward current | $I_F$ | 50 | mA |
| | 逆電圧 | Reverse voltage | $V_R$ | 5 | V |
| | パルス順電流 | Pulse forward current | $I_{FP}$ | — | A |
| 出力 Output | コレクタ損失 | Collector power dissipation | Pc | 50 | mW |
| | コレクタ電流 | Collector current | Ic | 20 | mA |
| | コレクタ-エミッタ間電圧 | Collector-Emitter voltage | $V_{CEO}$ | 30 | V |
| | エミッタ-コレクタ間電圧 | Emitter-Collector voltage | $V_{ECO}$ | 3 | V |
| | 動作温度 | Operating temp.*1 | Topr. | −20～+85 | ℃ |
| | 保存温度 | Storage temp.*1 | Tstg. | −30～+100 | ℃ |
| | 半田付温度 | Soldering temp.*2 | Tsol. | 240 | ℃ |

＊1. 氷結、結露の無き事
No icebound or dew
＊2. ケース端面より2mm離れた所で　t≦5s
For MAX. 5 seconds at the position of 2mm from the package

## ■電気的光学的特性　ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS

(Ta=25℃)

| Item | | | Symbol | Conditions | Min. | Typ. | Max. | Unit. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力 Input | 順電圧 | Forward voltage | $V_F$ | $I_F$=10mA | — | — | 1.3 | V |
| | 逆電流 | Reverse current | $I_R$ | $V_R$=5V | — | — | 10 | μA |
| | ピーク発光波長 | Peak wavelength | λp | $I_F$=20mA | — | 940 | — | nm |
| 出力 Output | 暗電流 | Collector dark current | $I_{CEO}$ | $V_{CE}$=10V | — | — | 0.2 | μA |
| 伝達特性 Transmission | 光電流 | Light current | $I_L$ | $I_F$=10mA, $V_{CE}$=5V | 90 | — | — | μA |
| | 漏れ電流 | Leakage current | $I_{CEOD}$ | $I_F$=10mA, $V_{CE}$=5V | — | — | 0.2 | μA |
| | 応答時間（立ち上がり） | Rise time | tr | $V_{CC}$=2V, $I_C$=0.1mA, $R_L$=1kΩ | — | 30 | — | μs |
| | 応答時間（立ち下がり） | Fall time | tf | | — | 25 | — | μs |

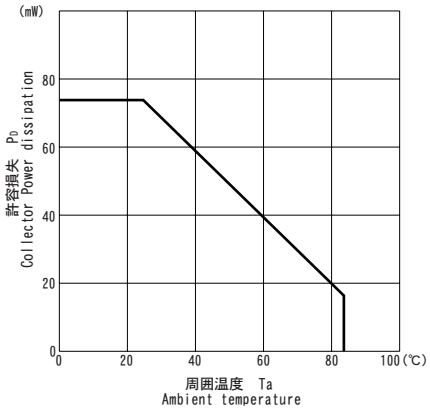
本資料に記載しております内容は、技術の改良、進歩等によって予告なしに変更されることがあります。ご使用の際には、仕様書をご用命のうえ、内容確認をお願い致します。

フォトインタラプタ　PHOTOINTERRUPTERS

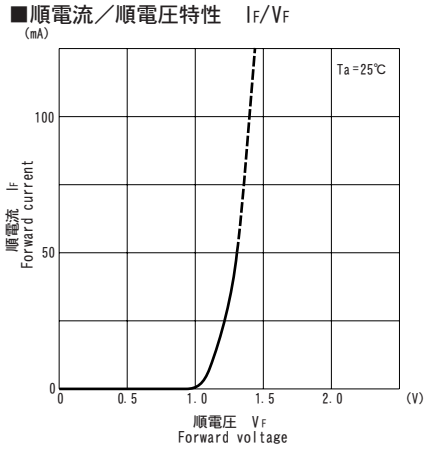
# SG-105

KODENSHI CORP.

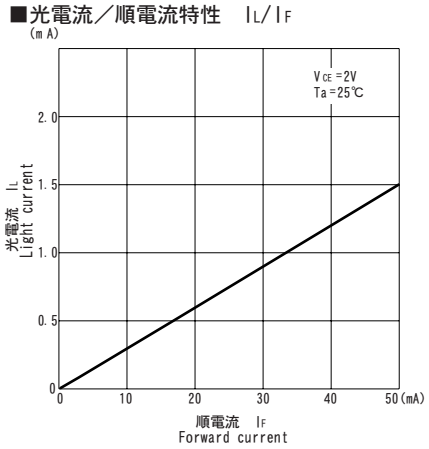
■許容損失/周囲温度　PD/Ta



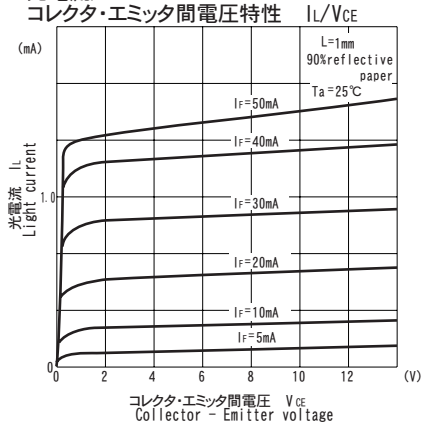

■順電流／順電圧特性　IF/VF



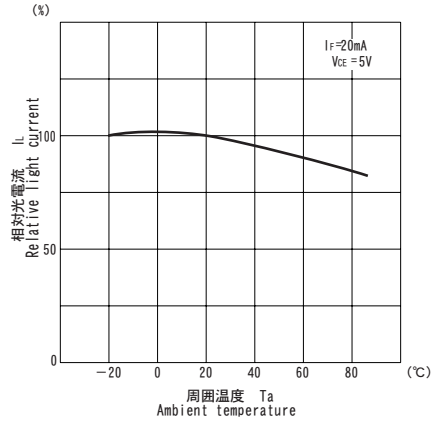

■光電流／順電流特性　IL/IF



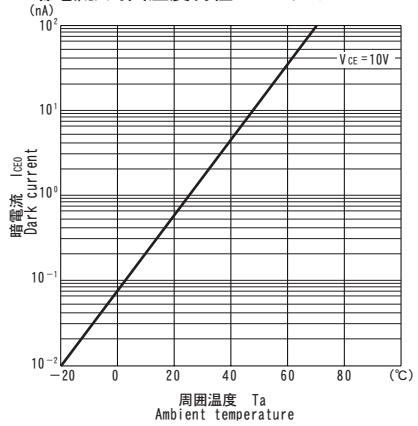

■光電流/
コレクタ・エミッタ間電圧特性　IL/VCE



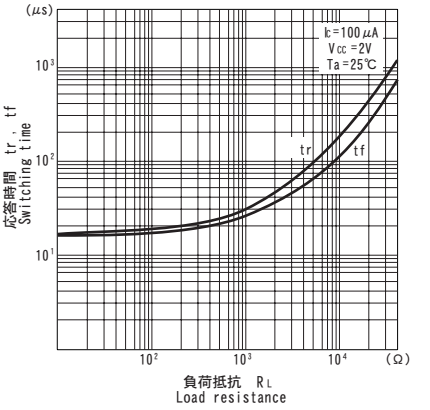

■相対光電流/周囲温度特性　IL/Ta



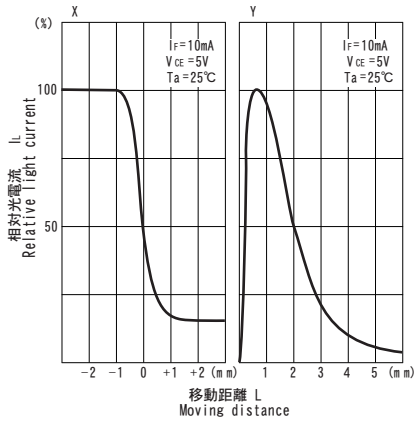

■暗電流/周囲温度特性　ICEO/Ta



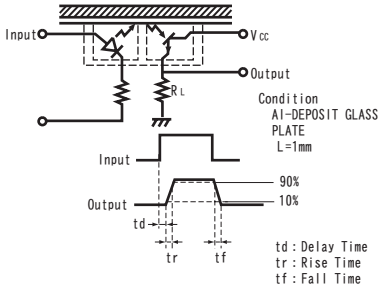

■応答時間／負荷抵抗特性　tr, tf/RL ※1

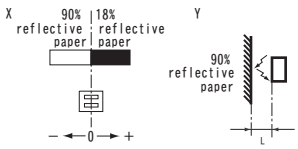



■位置検出特性　※2




＊1　Switching time measurement circuit




＊2　Method of measuring position detection characteristic